



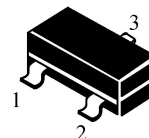
SOT-23 Bipolar Transistor 双极型三极管

■Features 特点

NPN Low equivalent on-resistance 低等效电阻

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	120	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	5	V
Collector Current 集电极电流	I_C	1000	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^{\circ}C)$	250	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	500	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}C$	

■Device Marking 产品打标

FMMT493=493



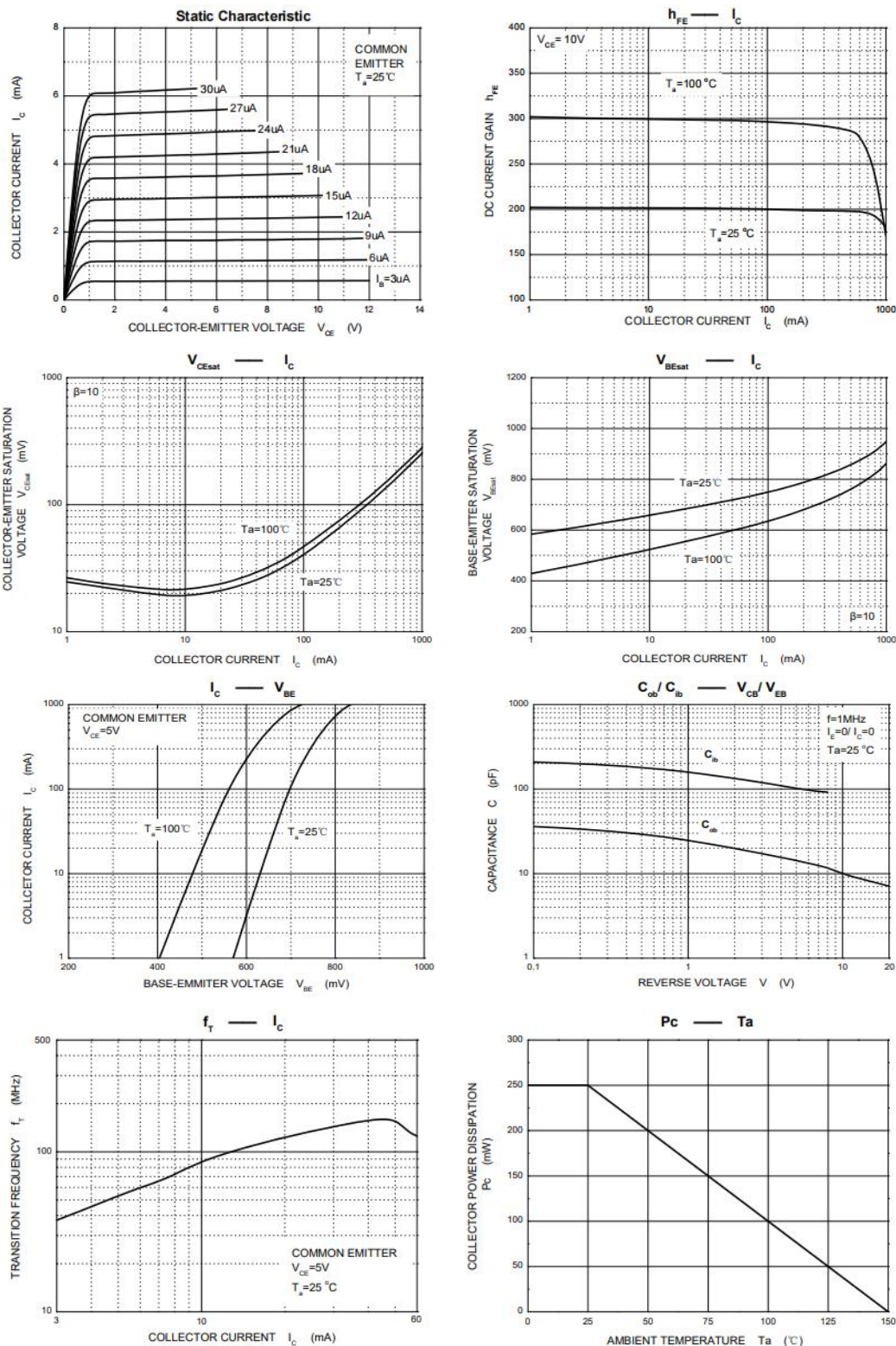
■ **Electrical Characteristics** 电特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压($I_C=100\mu\text{A}$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	120	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压($I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	100	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压($I_E=100\mu\text{A}$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	5	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流($V_{CB}=100\text{V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	100	nA
Collector-Emitter Leakage Current 集电极发射极漏电流($V_{CE}=100\text{V}$, $V_{BE}=0\text{V}$)	I_{CES}	—	—	100	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流($V_{EB}=4\text{V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	100	nA
DC Current Gain($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1\text{mA}$) 直流电流增益($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=250\text{mA}$) ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$) ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1000\text{mA}$)	H_{FE}	100 100 60 20	—	300	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$) ($I_C=1000\text{mA}$, $I_B=100\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.3 0.6	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降 ($I_C=1000\text{mA}$, $I_B=100\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.15	V
Base-Emitter On Voltage 基极发射极导通电压 ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1000\text{mA}$)	$V_{BE(on)}$	—	—	1	V
Transition Frequency 特征频率($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$)	f_T	150	—	—	MHz
Output Capacitance 输出电容($V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ob}	—	10	—	pF

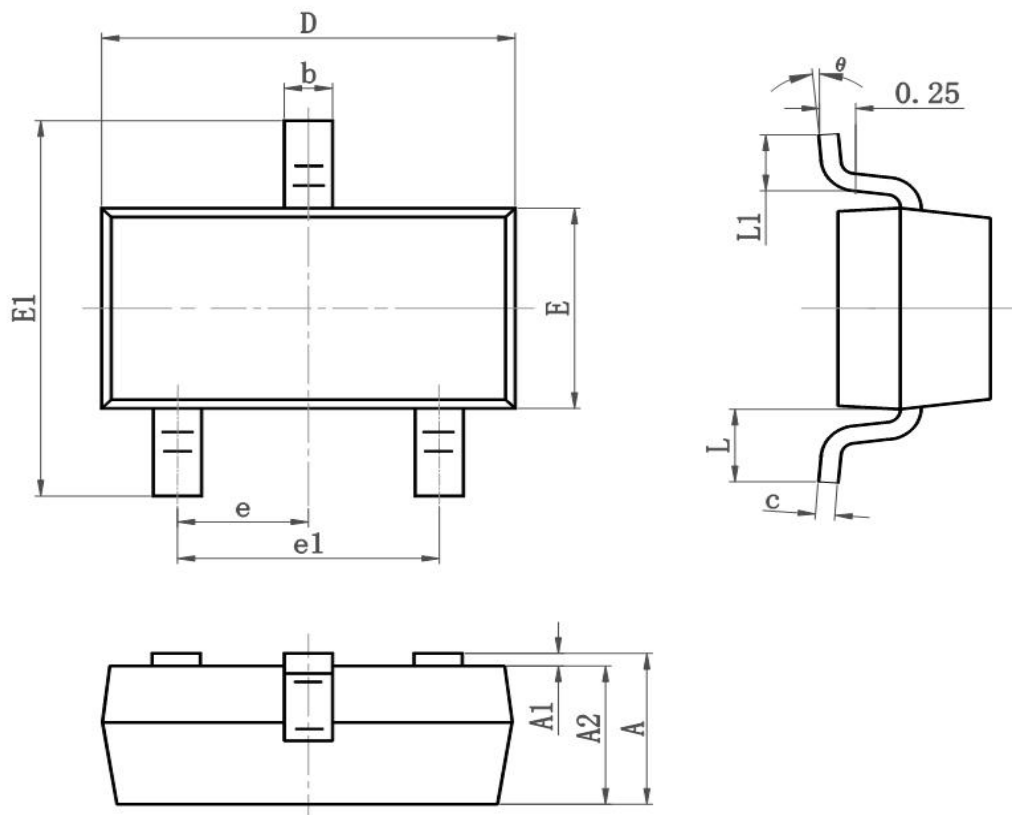


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线





■Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.050	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.900	1.00	0.035	0.039
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.500	0.600	0.020	0.024
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category:](#)

Click to view products by [Yongyutai Electronics manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC4731T-AY](#) [2SC5488A-TL-H](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2SB1324-TD-E](#) [2SC5231C8-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [BULD128DT4](#) [CPH6021-TL-H](#) [MCH6102-TL-E](#) [2N3879](#) [30A02MH-TL-E](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANSR2N2907AUB](#) [JANSR2N2222AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#) [Jantxv2N3810](#) [2N6678](#) [2N2907Ae4](#) [2N3963](#) [50C02MH-TL-E](#) [Jantx2N5415](#) [CPH3123-TL-E](#) [SMBT35200MT1G](#) [SMMJT350T1G](#) [NSVDTA113EM3T5G](#) [MBT3904DW1T1H](#)